

パワーエレトロニクス

(舟木担当分)

第一回

ダイオード整流回路

-半波整流回路-

平成17年5月30日月曜日 3限目

パワーエレクトロニクス授業構成

- ダイオード整流回路 (二回)
 - 回路方式
 - 抵抗負荷 誘導負荷・容量負荷
- サイリスタ逆変換・整流回路 (二回)
 - 回路方式
 - 点弧角制御
 - 転流
- 自励式変換器 (二回)
 - 回路方式
 - 制御方式
 - 高調波
- 時間に余裕があれば
 - サイクロコンバータ
 - マトリックスコンバータ

ダイオード

- ダイオードの種類
 - 整流用ダイオード
 - 電力用
 - 検波用
 - 定電圧ダイオード
 - 発光ダイオード
 - 可変容量ダイオード
 - トンネルダイオード
- ダイオードの材料
 - Si
 - Se
 - Ge
 - SiC

半導体整流器が出現する以前
に用いられていた二極管

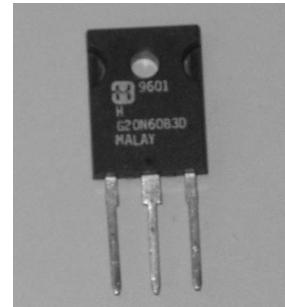
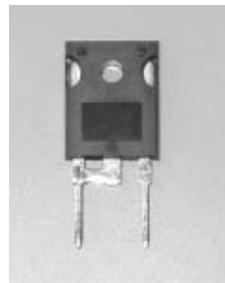
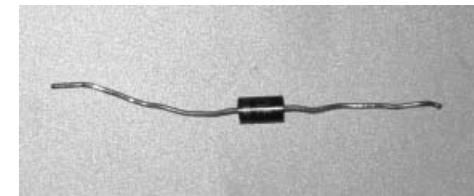
回路記号の絵



<http://homepage.mac.com/ryomasuda/VT/num/02/index.html>

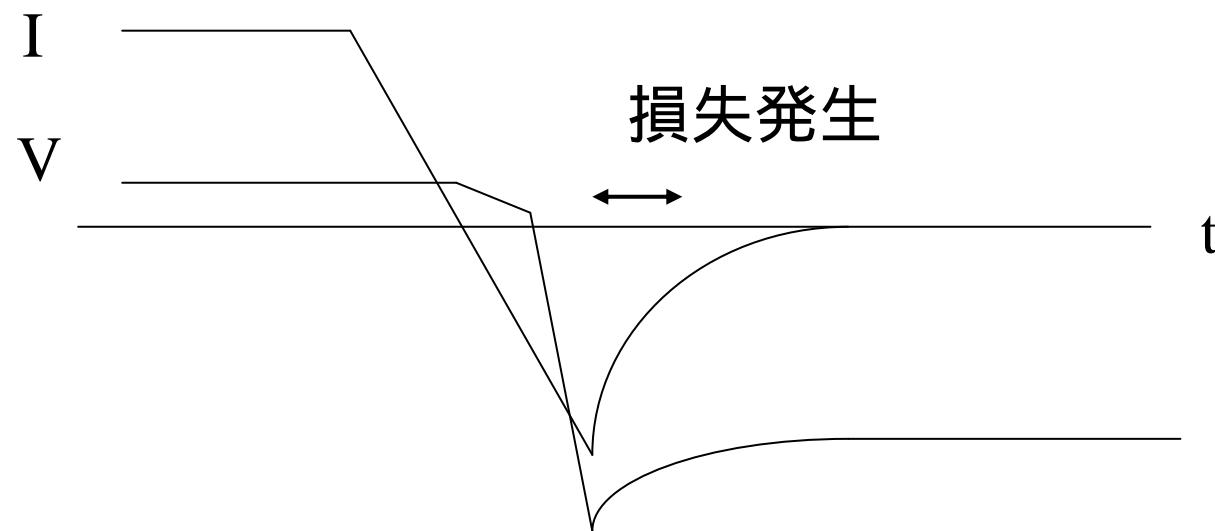
ダイオード

- パワエレでよく用いるダイオード VI特性の絵
 - PN接合ダイオード
 - 整流用
 - 10D1 100V1A0.9V($I_F = 1A$)
 - 大容量
 - PiNダイオード
 - 高耐圧
 - ファストリカバリ
 - ショットキダイオード
 - 低順方向電圧降下
 - 短逆回復時間
 - 漏れ電流大



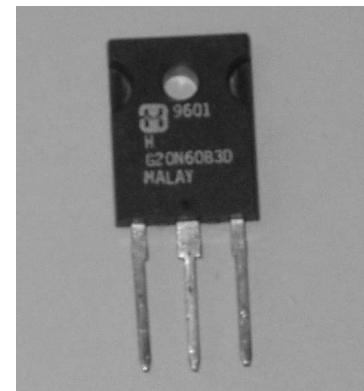
ダイオードのスイッチング時の応答

- 導通・非導通状態は瞬時には切り替わらない
 - 逆回復電流
 - スイッチング損失
 - 高周波になるほど深刻な問題

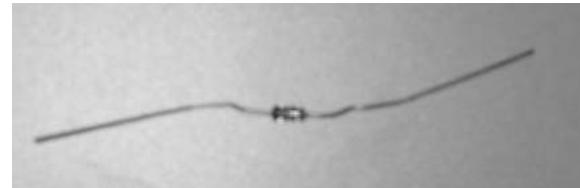


整流回路に用いるダイオード

- ・ ダイオードブリッジ
 - 単相フルブリッジ
 - 三相フルブリッジ
 - ハーフブリッジ



おまけ ツェナダイオード(定電圧用)



ダイオードを用いた整流回路

- 相数
 - 単相
 - 多相(三相)
 - 交流波形の利用形式
 - 全波整流回路
 - 半波整流回路
 - その他
 - 倍電圧整流回路
 - 負荷
 - 抵抗
 - 誘導性
 - 容量性
- 整流回路は、
電子機器の
電源に不可欠
な技術

单相半波整流回路

- 抵抗負荷

- 出力直流電圧を求める
 - 電源電圧

- 回路図
- 電圧・電流波形の図

$$v = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

- 直流出力電圧 e_d の平均値 E_d は？

$$E_d = \frac{1}{2p} \int_0^{2p} e_d d\omega t = \frac{1}{2p} \left[\int_0^p v d\omega t + \int_p^{2p} 0 d\omega t \right]$$

$$= \frac{1}{2p} \int_0^p \sqrt{2}V \sin \omega t d\omega t$$

$$= \frac{V}{\sqrt{2}p} [-\cos \omega t]_0^p = \frac{V}{\sqrt{2}p} [1 + 1]$$

- 直流電流の平均値は同様に

$$\therefore E_d = \frac{\sqrt{2}V}{p}$$

$$\therefore I_d = \frac{E_d}{R}$$

单相半波整流回路

- 抵抗負荷

- 出力電圧波形に含まれる高調波
 - 出力電圧 e_d のフーリエ級数展開

$$\begin{aligned} E_{dk} &= \frac{1}{2p} \int_0^{2p} e_d e^{-jkwt} dwt = \frac{1}{2p} \left[\int_0^p v e^{-jkwt} dwt + \int_p^{2p} 0 e^{-jkwt} dwt \right] \\ &= \frac{V}{\sqrt{2p}} \int_0^p \sin wte^{-jkwt} dwt \end{aligned}$$

$$\sin wt = \frac{e^{jwt} - e^{-jwt}}{2j} \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} E_{dk} &= \frac{V}{\sqrt{2p}} \int_0^p \frac{e^{jwt} - e^{-jwt}}{2j} e^{-jkwt} dwt \\ &= \frac{V}{j2\sqrt{2p}} \int_0^p [e^{j(1-k)wt} - e^{-j(1+k)wt}] dwt \end{aligned}$$

单相半波整流回路

- 抵抗負荷

- 出力電圧波形に含まれる高調波
 - 出力電圧 e_d のフーリエ級数展開

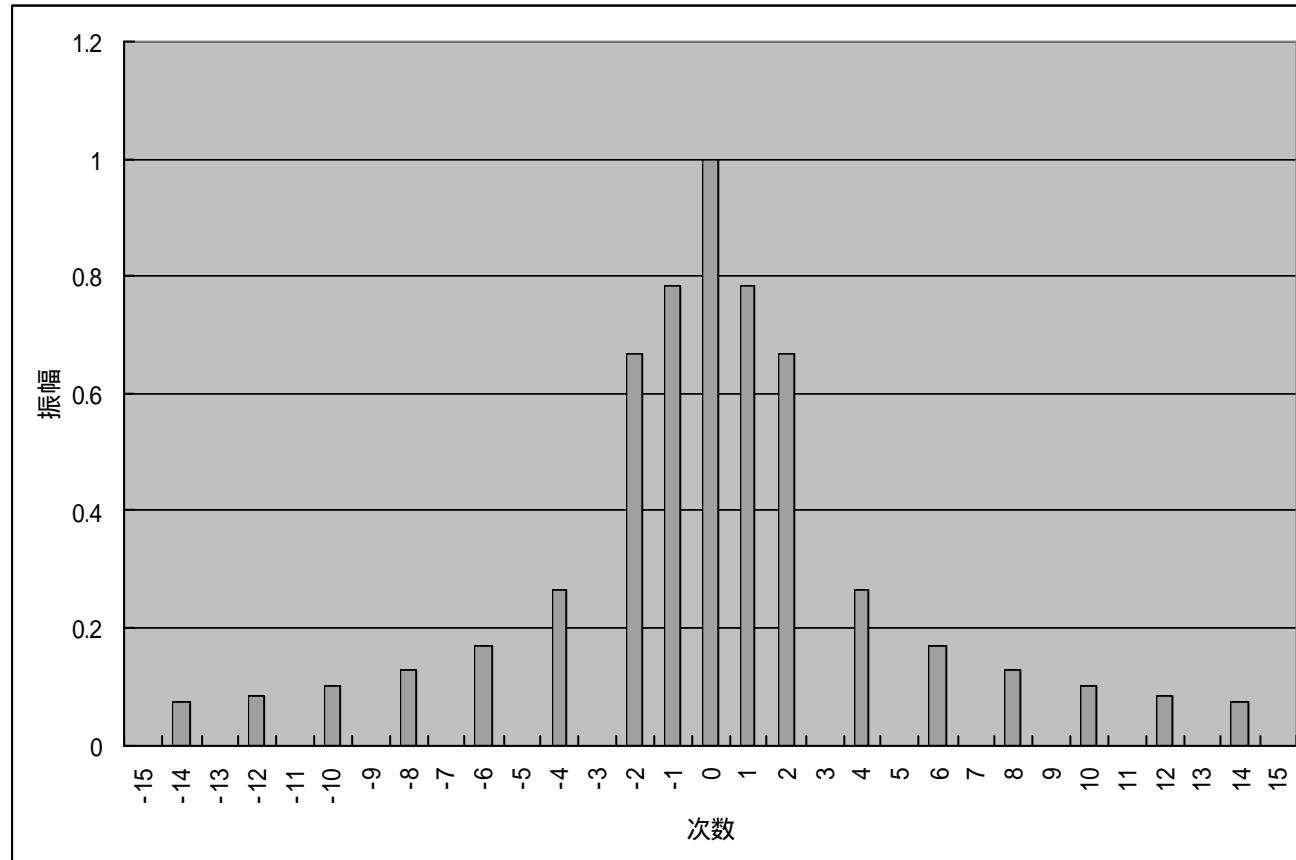
$$k \neq \pm 1 \quad E_{dk} = \frac{V}{j2\sqrt{2}p} \left[\frac{e^{j(1-k)wt}}{j(1-k)} + \frac{e^{-j(1+k)wt}}{j(1+k)} \right]_0^p$$

$$k = 1 \quad E_{dk} = \frac{V}{j2\sqrt{2}p} \int_0^p \left[1 - e^{-j2wt} \right] dwt$$
$$= \frac{V}{j2\sqrt{2}p} \left[wt + \frac{1}{j2} e^{-j2wt} \right]_0^p = \frac{V}{j2\sqrt{2}}$$

$$k = -1 \quad E_{dk} = \frac{V}{j2\sqrt{2}p} \int_0^p \left[e^{j2wt} - 1 \right] dwt$$
$$= \frac{V}{j2\sqrt{2}p} \left[\frac{1}{j2} e^{j2wt} - wt \right]_0^p = -\frac{V}{j2\sqrt{2}}$$

单相半波整流回路

- 抵抗負荷
 - 出力電圧波形に含まれる高調波
 - 出力電圧 e_d のフーリエ級数展開



但し, 平均直流電圧
を1として規格化

单相半波整流回路

- 誘導負荷

- 電圧・電流の振る舞い

- 電源電圧

- 回路図

$$v = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

- ダイオードの導通期間中, 電圧はL,Rが分担

- Lの印加電圧

$$e_L = L \frac{d}{dt} i_d$$

- Rの印加電圧

$$e_R = R i_d$$

- 印加電圧

- » 導通期間中

$$e_d = e_L + e_R = v$$

- » 非導通期間中

$$e_d = e_L + e_R = 0$$

单相半波整流回路

- 誘導負荷

- 出力電流波形を求める

- ダイオード導通開始点をt=0とする

$$v = e_L + e_R = L \frac{d}{dt} i_d + R i_d$$

$$\sqrt{2}V \frac{W}{s^2 + W^2} = LsI_d + RI_d \quad v_{t=0} = 0, i_{dt=0} = 0$$

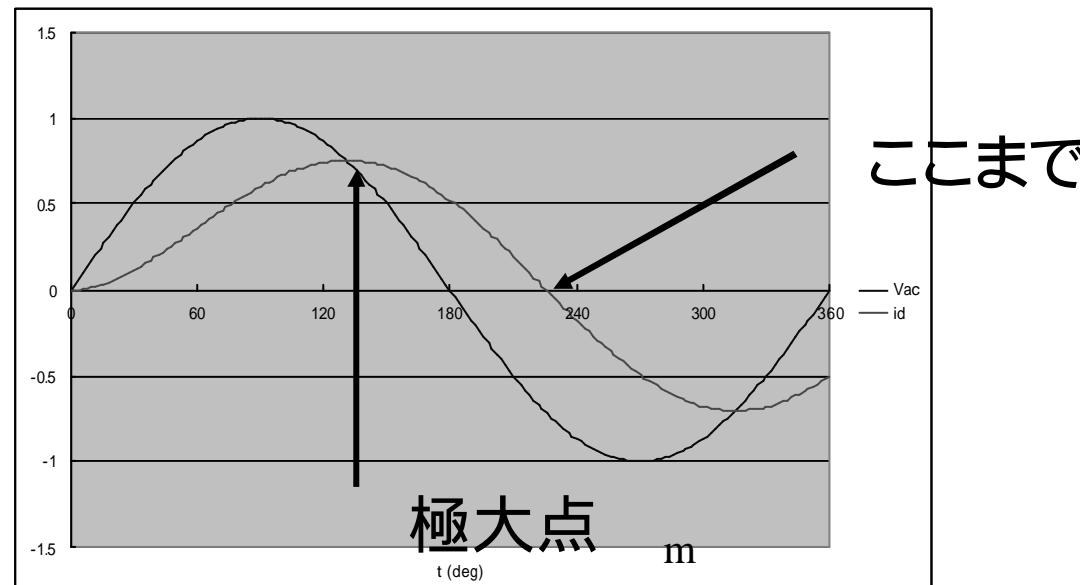
$$I_d = \sqrt{2}V \frac{W}{s^2 + W^2} \frac{1}{Ls + R}$$

$$I_d = \frac{\sqrt{2}V}{R^2 + W^2 L^2} \left(\frac{WL}{s + \frac{R}{L}} - WL \frac{s}{s^2 + W^2} + R \frac{W}{s^2 + W^2} \right)$$

单相半波整流回路

- 誘導負荷
 - 出力電流波形を求める

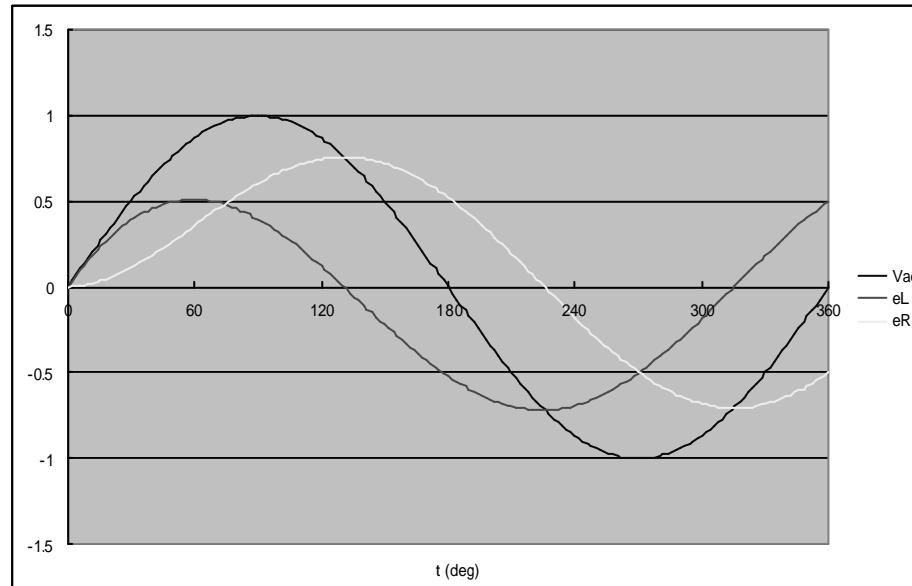
$$\begin{aligned}i_d &= \frac{\sqrt{2}V}{R^2 + w^2 L^2} \left(wL e^{-\frac{R}{L}t} - wL \cos wt + R \sin wt \right) \\&= \frac{\sqrt{2}V}{R^2 + w^2 L^2} \left[wL \left(e^{-\frac{R}{L}t} - \cos wt \right) + R \sin wt \right]\end{aligned}$$



单相半波整流回路

- 誘導負荷
 - 各部の電圧波形を求める
 - 負荷抵抗電圧
 - 電流と相似波形 $e_R = R i_d$
 - インダクタ電圧

$$e_L = L \frac{d}{dt} i_d = \frac{\sqrt{2} w L V}{R^2 + w^2 L^2} \left[-R \left(e^{-\frac{R}{L} t} - \cos w t \right) + w L \sin w t \right]$$



单相半波整流回路

- 誘導負荷

- 各部の電圧波形を求める

- e_R は π で電源電圧と同じになる

- e_L は π で0

- これ以降, 負の値

- » $I_d > 0$ の間はオン

- $t = \pi$ でオフ

- を消弧角

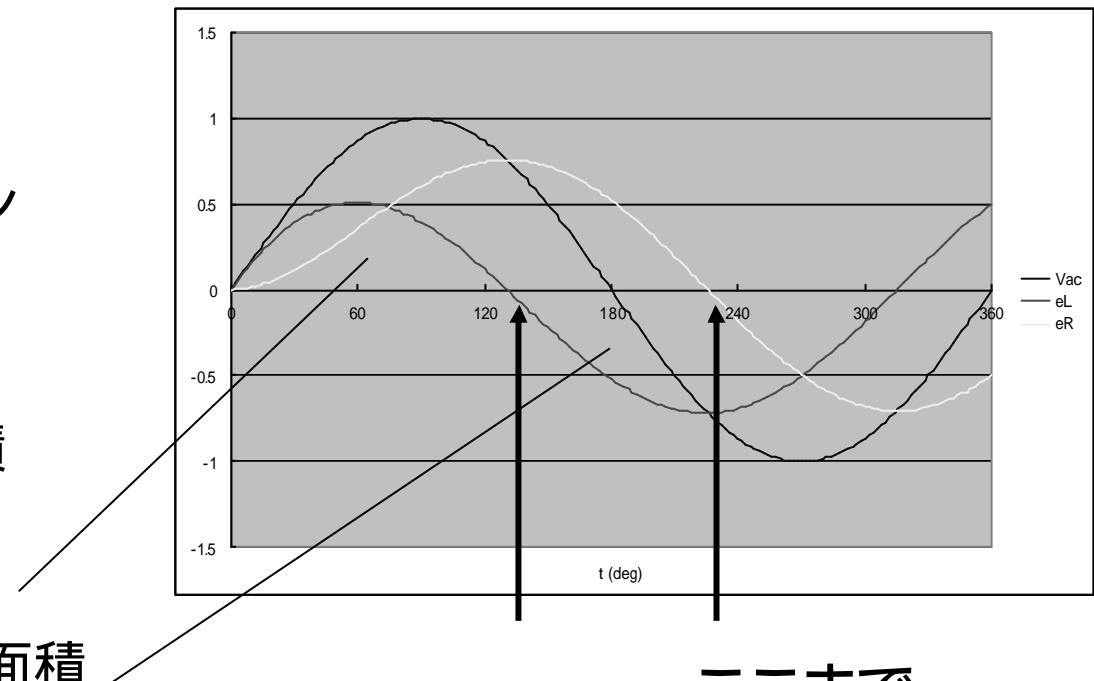
- Lのエネルギー蓄積

- » $0 \sim \pi$ の面積
磁束増加

- » $\pi \sim \pi$ の面積

- 磁束減少

- » 両者の面積は等しくなる



ここまで
+
 π

单相半波整流回路

- 誘導負荷

- 消弧角 を求める

- 消弧 (ダイオードオフ) 時の条件 $i_d(wt = p + b) = 0$

$$\frac{V}{R^2 + w^2 L^2} \left[wL \left(e^{-\frac{R}{wL} \{p + b\}} - \cos \{p + b\} \right) + R \sin \{p + b\} \right] = 0$$

$$e^{-\frac{R}{wL} (p + b)} + \cos b = \frac{R}{wL} \sin b$$

- インダクタ電圧が0となる点 q_m を求める

- e_L が0となる条件 $e_L(wt = q_m) = 0$

$$\frac{wLV}{R^2 + w^2 L^2} \left[-R \left(e^{-\frac{R}{wL} q_m} - \cos q_m \right) + wL \sin q_m \right] = 0$$

$$e^{-\frac{R}{wL} q_m} - \cos q_m = \frac{wL}{R} \sin q_m \quad \text{数値的に求解}$$

单相半波整流回路

- 誘導負荷

- 電圧・電流波形を求める

- 直流出力電圧 e_d の平均値 E_d は？

$$E_d = \frac{1}{2p} \int_0^{2p} e_d dwt = \frac{1}{2p} \left[\int_0^p v dwt + \int_p^{2p} 0 dwt \right]$$

$$= \frac{1}{2p} \int_0^p \sqrt{2}V \sin wt dwt$$

$$= \frac{V}{\sqrt{2}p} \left[-\cos wt \right]_0^p = \frac{V}{\sqrt{2}p} [1 + 1]$$

$$\therefore E_d = \frac{\sqrt{2}V}{p}$$

- 直流電流の平均値は同様に

$$\therefore I_d = \frac{E_d}{R}$$

单相半波整流回路

- 容量負荷

- 電圧・電流の振る舞い

- 電源電圧

$$v = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

- 回路図

- 導通期間中, 負荷電圧は電源電圧と等しい

- オンは, 電源電圧と負荷電圧が等しくなった時点

- オン時, Cを充電するため大電流が流れる(可能性)

$$e_d = v \quad i_d = i_C + i_R = C \frac{d}{dt} e_d + \frac{e_d}{R}$$

- 非導通期間中, RCで閉回路を構成

- Rを介してCが放電

$$i_C = -i_R$$

$$i_R = -C \frac{d}{dt} e_d$$

单相半波整流回路

- 容量負荷
 - 出力波形を求める

- 導通開始点
 - コンデンサ電圧初期値を v_{c0} とする

$$v = v_{C0} = \sqrt{2}V \sin q_{on}$$

- 導通終了点

- i_d が 0 となる
 - 導通期間中 $e_d = v$

$$i_d \left(\text{wt} = q_{off} \right) = C \frac{d}{dt} e_d + \frac{e_d}{R} = 0$$

$$C \sqrt{2}V \cos q_{off} + \frac{\sqrt{2}V \sin q_{off}}{R} = 0 \quad \frac{p}{2} < q_{off} \text{ になるので} \\ \therefore q_{off} = p - \arctan RW C$$

单相半波整流回路

- 容量負荷
 - 出力波形を求める
 - 非導通期間中

$$i_R = -C \frac{d}{dt} e_d \quad \frac{e_d}{R} = -C \frac{d}{dt} e_d$$

$$\frac{E_d}{R} = -C(sE_d - e_{d0}) \quad \text{但し } e_{d0} = \sqrt{2}V \sin \mathbf{q}_{off}$$

$$E_d = \frac{e_{d0}}{s + \frac{1}{RC}}$$

- 非導通開始点 $_{off}$

- 出力電圧 $e_d = e_{d0} e^{-\frac{1}{RC}(\mathbf{wt} - \mathbf{q}_{off})}$

- 波形の図

单相半波整流回路

- 容量負荷
 - 出力波形を求める
 - v_{c0} と e_{d0} の接続条件 (非導通 導通 の時点)

$$e_d (wt = 2p + q_{on}) = e_{d0} e^{-\frac{1}{RwC} (2p + q_{on} - q_{off})} = v_{c0}$$

$$v_{c0} = e_{d0} e^{-\frac{1}{RwC} (2p + q_{on} - q_{off})}$$

$$v_{c0} = \sqrt{2}V \sin q_{on} \quad e_{d0} = \sqrt{2}V \sin q_{off} \quad \text{より}$$

$$\sqrt{2}V \sin q_{on} = \sqrt{2}V \sin q_{off} e^{-\frac{1}{RwC} (2p + q_{on} - q_{off})}$$

$$\sin q_{on} = \sin q_{off} e^{-\frac{1}{RwC} (2p + q_{on} - q_{off})} \quad \text{の解として } q_{on} \text{ が求まる}$$

負荷に対する単相半波整流回路の比較

- 抵抗負荷
 - 導通角 = 180度
- 誘導性負荷
 - 導通角 > 180度
 - 抵抗負荷より出力電圧・電流に含まれる高調波小
- 容量性負荷
 - 導通角 < 180度
 - 平滑コンデンサへの入力電流に含まれる高調波大
 - 平滑コンデンサが,出力電圧の高調波を低減